

1. Обзоры по электронной технике. Серия 2. Полупроводниковые приборы. вып.3, 1983 г., М., Т.М.Колмакова, Г.Ф.Лымарь. “Выращивание эпитаксиальных слоев фосфида индия в системе In-PCl<sub>3</sub>-H<sub>2</sub> для полевых транзисторов”.
2. R.D.Fairman, M.Omozi, E.B.Fank. Recent progress in the control of high-purity VPE by the PCl<sub>3</sub>-In-H<sub>2</sub> technology. The 6th Symp. on GaAs and related compounds. London. 1977, p. 45-54.